

КП750А-Г

МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ

МОП ТРАНЗИСТОР

АДБК 432140.685 ТУ

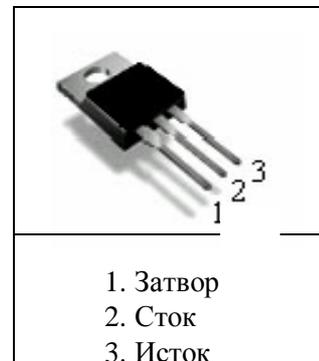
КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ И ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ, В РЕГУЛЯТОРАХ, СТАБИЛИЗАТОРАХ С НЕПРЕРЫВНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, БЛОКАХ ПИТАНИЯ ЭВМ, СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРОЙ.

* Зарубежный аналог - **IRF640, 641, 642, IRL640**

* Изготавливается в корпусе КТ-28 (ТО-220).

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Предельные значения			
			А	Б	В	Г
Напряжение сток-исток	Uси max	В	200	150	200	200
Напряжение затвор-исток	Uзи max	В	±20	±20	±20	±10
Постоянный ток стока при Tк=25 С	Iс max	А	18	18	16	18
Постоянный ток стока при Tк=100 С	Iс max	А	11	11	10	11
Импульсный ток стока	Iс и max	А	72	72	64	72
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	125	125	125	125
Температура перехода	Tпер	°С	150	150	150	150



В диапазоне температур корпуса от 25 до 100 °С максимально-допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле $P_{max} = (T_{пер\ max} - T_{корп}) / R_{t\ п-к}$

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (T_{корп.}=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Min	Max	
Пороговое напряжение	КП750А-В КП750Г	Uзи пор	В	Iс=0.25мА, Uзи=Uси	2.0 1.0	4.0 2.0
Ток стока	КП750А,Б КП750В, КП750Г	Iс	А	tи<300мкс. Q >50 Uси=4.0В, Uзи=10В Uси=4.4В, Uзи=10В Uси=4.0В, Uзи= 5В	18.0 16.0 18.0	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	КП750А,Б КП750В КП750Г	Rси отк	Ом	tи<300мкс. Q >50 Iс=11А, Uзи=10В Iс=11А, Uзи=10В Iс=11А, Uзи= 5В		0.18 0.22 0.18
Остаточный ток стока		Iс ост	мкА	Uси= Uси max, Uзи=0		250
Ток утечки затвора		Iз ут.	нА	tи<300мкс. Q >50 Uси=0, Uзи= Uзи max	-100	+100
Крутизна ВАХ	КП750А-В КП750Г	S	А/В	tи<300мкс. Q >50 Uси=25В, Iс=11А Uси=25В, Iс=11А	6.7 7.5	
Время включения/выключения		* твкл/ твыкл	нс	tи ≤300мкс. Q ≥50, Uси=100В, Iс=Iсmax Rг=9.1Ом, Rси=5.4Ом		65/80
Тепловое сопротивление переход-корпус		* Rt п-к	°С/Вт			1.0
Тепловое сопротивление переход-среда		* Rt п-с	°С/Вт			62
Емкость: входная/выходная проходная	КП750А,Б,В КП750Г	* C _{11и} /C _{22и} C _{12и}	пФ	Uзи=0, Uси=25В, f=1МГц		1800/600 180 2450/600 180
Прямое напряжение диода	КП750А,Б,Г КП750В	Uпр	В	Uзи=0, Iс= 18А Uзи=0, I=16А		2.0 1.9

* Справочные параметры

Диапазон рабочих температур корпуса от -55 до +100°С

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16 УП "Завод Транзистор"

Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>